

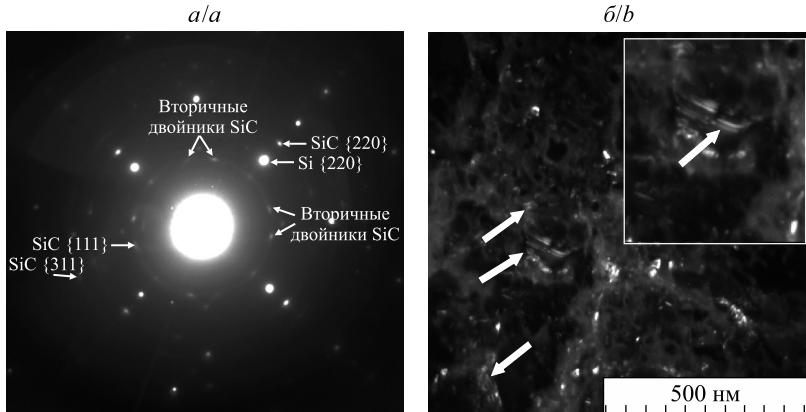


Рис. 2. ПЭД-микрофотография (а) и ПЭМ-изображение в темном поле (б) эпитаксиального слоя SiC, выращенного на лицевой стороне подложки Si (100) при 1100 °С в течение 30 с

Fig. 2. Transmission electron diffraction pattern (a) and transmission electron microscopy image in dark field mode (b) of epitaxial SiC layer grown on the front side of a Si (100) substrate at 1100 °C during 30 s